# بررسی تاثیر نوع و نرخ تزریق گاز محافظ داخلی بر خصوصیات ریزساختاری پوشش ZrC اعمال شده با روش پاشش پلاسمایی با غلاف جامد/گاز محافظ (SSPS) و مقایسه با یوشش پلاسمایی اتمسفری (APS)

اکبر اسحاقی، ضیا والفی، ناصر احسانی *تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع مواد و فناوری های ساخت* (دریافت مقاله: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - پذیرش مقاله: ۱۴۰۱/۰۸/۲۴)

چکیدہ

در این تحقیق پوشش ZrC با روش پاشش پلاسمایی با غلاف جامد و گازهای محافظ (SSPS) با تزریق گاز محافظ داخلی Ar و H<sub>2</sub> با نرخ متفاوت بر روی زیر لایه گرافیتی(دارای پوشش SiC) اعمال شد و کیفیت ریز ساختار پوششهای اعمال شده با مقایسه با پوشش پلاسمایی مرسوم (APS) مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا اثر نرخ و نوع گازهای تزریق شده بر ریزساختار پوشش با مطالعه مورفولوژی ذرات در آزمون پاشش تک عبور بررسی شدند و همچنین ریزساختار و فازهای موجود در پوششها به همراه درصد تخلخل و مقدار اکسید آنها ارزیابی گردیدند. با مقایسه تصاویر سطح و سطح مقطع پوششها، نتایج نشان می دهند پوشش اعمالی با روش SSPS و با تزریق گاز هیدروژن داخلی با نرخ آسب ۲۰ به درون غلاف، میزان ذرات ذوب شده /اسپلتها و پهن شدگی آنها در این پوشش افزایش و مقدار تخلخل موجود در ریزساختار آن بیش از ۵۰٪ نسبت به پوشش APS کاهش داشته است. سوختن هیدروژن با اکسیژن وارد شده به جت موجب مصرف اکسیژن و کاهش مقدار آن و تشکیل مقدار اکسید (۵۰٪) کمتر در پوشش و همچنین افزایش گرما و دمای اطراف جت پلاسما و افزایش میزان ذرات ذوب شده در پوشش مقدار آن و تشکیل مقدار اکسید (۵۰٪) کمتر در پوشش و همچنین افزایش گرما و دمای اطراف جت پلاسما و افزایش میزان ذرات ذوب شده در پوشش As مقدار آن و تشکیل مقدار اکسید (۵۰٪) کمتر در

# The effect of inner shrouded gases rate on the microstructure of ZrC coating applied by solid shrouded plasma spraying (SSPS) and compared to atmospheric plasma spraying (APS)

# Akbar Eshaghi, Zia Valefi, Naser Ehsani

Faculty of Materials & Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

(Received 21 June 2022, accepted 15 November 2022)

#### Abstract

In this study, the effect of injection of argon and hydrogen shielding gases on the properties of ZrC coatings, applied by solid shield plasma spraying (SSPS) and comparison with APS method were investigated. The effect of type and rate of injected gases on the microstructure of the coating were investigated by studying the morphology of the particles in the Single-line scan-spray. Also, the microstructure and phases of the coatings along with their porosity and oxide content were evaluated. The results show that the coating applied by SSPS method and injection of internal hydrogen gas at a rate of 20 l/min leads to an increase in the amount of splats in the coating and a decrease of more than 50% in the amount of oxides and porosity in the microstructure compared to APS coating. The  $H_2$  gas is injected to solid shield burns with  $O_2$  that caused a reduction in the amount of oxides in SSPS coatings and increase the heat and temperature around the plasma jet and increase the amount of molten particles in the coatings.

Key words: Plasma spray, Solid shield and Shrouded gas, ZrC coating.

E-mail of Corresponding author: akbareshaghi@yahoo.com, Valefi@mut.ac.ir.

### مقدمه

امروزه مواد پایه کربنی از جمله گرافیت به عنوان یکی از مواد برجسته برای استفاده در کاربردهای دمای بالا در صنایع مختلف است که این موضوع به دلیل استحکام به وزن بالا، دانسیته پایین و هدایت حرارتی و مقاومت مناسب آن به شوک حرارتی میباشد[ او ۲]. با این حال این مواد از دماهای بالاتر از ۲°۵۰۰ و در اتمسفر اکسیدی شروع به اکسید شدن نموده و لذا کاربرد این مواد بیشتر به اتمسفرهای خنثی محدود می شود[ ۳–۵].

از این رو استفاده از مواد پایه کربنی از جمله گرافیت در کاربردهای دما بالا و در مواجه با گازهای فرساینده داغ، نیازمند بهبود بخشیدن مقاومت به اکسیداسیون و فرسایش این مواد است[۵و۶]. یکی از روشهای جلوگیری از اکسیداسیون و بهبود مقاومت به فرسایش مواد کربنی و گرافیت، اعمال پوششهای سرامیکی از جمله SiC، SiC، میاشد[۷–۱۰].

اعمال پوشش کاربید زیرکونیم(ZrC) با دمای ذوب بالا (حدود ۲۰٬۳۴۰)، هدایت حرارتی مناسب، چگالی پایین و ایجاد اکسید ZrO<sub>2</sub> پایدار با دمای ذوب بالا تأثیر مثبتی در بهبود مقاومت به فرسایش گرافیت در برابر جریان فرساینده با دما و فشار بالا دارد[۴و ۸و ۱۱]. همچنین اعمال پوشش SiC به عنوان لایه میانی با روشهایی مانند سمانتاسیون تودهای که به صورت تغییر تدریجی از سطح تا قسمتهای داخلی گرافیت تشکیل می شود، موجب کاهش اختلاف ضریب انبساط حرارتی و کاهش تنش حرارتی در پوشش می شود[۱۲].

در بین روش های اعمال پوشش های سرامیکی دمای بالا ('UHTC) مانند ZrC و ZrBZ و...، روش پاشش پلاسمایی با برخورداری از جت پلاسما با دمای بیش از ۵۰۰۰۰۰ و انرژی جنبشی بالا (به دلیل ایجاد سرعت بالا در حدود سرعت صوت) و راندمان بالای پوشش دهی

در مقایسه با روشهای دیگر همچون روش دوغابی، روش رسوب شیمیایی و فیزیکی از فاز بخار و ... دیگر روشهای متداول، روش مناسبی برای اعمال این پوششهای UHTC محسوب می شوند[۱، ۶ و ۱۳].

به منظور كاهش اكسيداسيون ذرات پودر مواد تشكيل دهنده پوشش در حين پاشش پلاسمايي، استفاده از خلأ و روش،هایی مانند روش پاشش پلاسمایی در خلأ (VPS<sup>۲</sup>)، روش پاشش پلاسمایی در فشار پائین با استفاده از محفظههای خلاً ("LPPS) و یا با روش پاشش پلاسمایی با غلاف جامد و گاز محافظ (<sup>\*</sup>SSPS) در مقايسه با روش پاشش پلاسمايي متداول اتمسفري (APS<sup>a</sup>) مورد توجه می باشند. در بین روش های پاشش پلاسمایی تحت حفاظت یا کنترل شده، روش SSPS به دلیل عدم نیاز به تجهیزات خلأ گران قیمت در مقایسه با روشهای VPS و LPPS و تنها استفاده از غلاف جامد و تزريق گازهاي محافظ داخلي و خارجي مورد توجه بسيار قرار گرفته است[ او ۱۴ و ۱۵]. استفاده از غلاف جامد در حين پاشش باعث كاهش تماس جت پلاسما با اتمسفر اطراف و لذا كاهش اكسيداسيون ذرات در حين ياشش می شود. همچنین برای کاهش اکسیداسیون و محافظت ذرات خارج شده از غلاف و تا زمان نشستن ذرات رسوب روی زیرلایه از دوش گاز محافظ خارجی و با تزريق از طريق منافذ بيروني غلاف جامد تا سطح زيرلايه استفاده مي شود[۱۴و ۱۶].

در این تحقیق با اعمال پوشش های ZrC با روش APS و روش پاشش پلاسمایی با غلاف جامد و گاز محافظ (SSPS) روی زیرلایه گرافیتی (دارای پوشش SiC) و مقایسه آنها با یکدیگر، تأثیر غلاف جامد و نرخ تزریق گاز محافظ داخلی هیدروژن و گاز محافظ خارجی آرگون

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vacuum Plasma Spray

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Low Pressure Plasma Spray

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Solid shielding Shrouded Plasma Spray

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Atmospheric Plasma Spray

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ultra High Temperature Coating

بر ریزساختار و کیفیت پوششهای ZrC بررسی شده است.

# مواد و روش آزمایش

در این تحقیق و به منظور اعمال پوششها، از زیرلایههای گرافیتی با ابعاد ۲۵۳۳×۲۵×۲۵، با چگالی تقریبی ۲۸۲g/cm<sup>3</sup> استفاده شد. ابتدا پوشش لایه اول (یا لایه میانی) SiC با روش سمانتاسیون تودهای روی زیرلایه گرافیتی ایجاد شد. اجزاء سازنده پوشش SiC شامل پودرهای سیلیسیم، گرافیت و آلومینا میباشند و پارامترهای عملیات حرارتی ایجاد پوشش SiC با روش سمانتاسیون تودهای بر اساس مطالعات پیشین در زمینه اعمال پوشش SiC انتخاب شدهاند[۹و ۱۲]. پوشش لایه تفنگ پلاسمای SiC ساخت شرکتسولزر متکو<sup>2</sup> (کشور سوئیس) و پودرهای آگلومره شده در محدوده اندازه سوئیس) و پودرهای آگلومره شده در محدوده اندازه SiC عمال شد. در جدول ۱ خواص فیزیکی ترکیبات SiC و SiC به عنوان پوشش ارایه شده است.

**جدول ۱**. خواص فیزیکی ترکیبات SiC و ZrC

SiC	ZrC	نام ترکیب / خواص فیزیکی
۲۸۰۰	44	(°C) دمای ذوب
۳/۲	۶/۵	(g/cm <sup>3</sup> ) دانسیته
۴/۵	۶/۷۳	$^{-6}$ فريب انبساط حرارتی $^{-6}$ (1/K)

بارامترهای پاشش پلاسمایی مورد استفاده در روش APS در جدول ۲ و تصاویر شماتیکی روش پاشش پلاسمایی اتمسفری (APS) و تصویر پاشش پلاسمایی با غلاف جامد وگاز محافظ (SSPS) در شکل ۱ نشان داده شده است.همانگونه که در شکل ۱-ب مشاهده می شود جریان گازهای محافظ داخلی H2 و AF خارجی موازی با جت پلاسما و جریان تزریق پودر عمود بر جریان جت است.

جدول۲. پارامترهای پاشش در اعمال پوشش ZrC با فرآیند APS

واحد	مقدار	متغير
А	۶	جريان
V	۵۰	ولتاژ
KW	774	توان
l/min	۳۵	نرخ شارش گاز اولیه (Ar)
l/min	١٢	نرخ گاز ثانویه (H2)
l/min	٣	نرخ گاز حامل پودر(Ar )
g/min	٨	نرخ تغذيه پودر
Cm	٨	فاصله پاشش
mm/s	٨	سرعت جابجایی تفنگ

در این تحقیق نرخ تزریق گاز آرگون خارجی برای کلیه پوششهای SSPS، مقدار ثابت ۳۰۱ ۳۰ و تأثیر گازهای داخلی تزریق شده شامل آرگون و هیدروژن با نرخ های متفاوت بر ریز ساختار و خواص پوششهای ZrC اعمال شده با روش SSPS بررسی گردید.



(APS) و ب) پاشش پلاسمایی با غلاف جامد و گاز محافظ (SSPS) با تزریق H2 داخلی و Ar خارجی.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sulzer-Metco

آزمون پاشش تک عبور ذرات پاششی مطابق با جدول ۳، با تزریق نرخهای مختلف گاز محافظ داخلی H<sub>2</sub> و Ar (و با تزریق گاز محافظ خارجی Ar با نرخ جریان ثابت ارمون با عبور سریع شیشه های با ابعاد mo ۲/۵ × ۲/۵ به عنوان زیرلایه از مقابل گان در دمای محیط، ذرات روی سطح شیشه نشسته و به لحاظ ابعاد و مورفولوژی ظاهری مورد بررسی قرار می گیرند.

پس از آزمون پاشش تک عبور کاربید زیرکونیم، پوششهای ZrC با استفاده از روشهای APS و SSPS بر طبق جدول ۴ با نرخهای مختلف تزریق گاز محافظ داخلی H<sub>2</sub> و نرخ ثابت گاز Ar خارجی روی گرافیتهای دارای پوشش SiC، اعمال شدند.

جدول ۳. کد ذرات و نرخ گاز محافظ در آزمون پاشش تک عبور

نرخ تزريق	نرخ تزريق	نوع گاز محافظ		کد
گاز خارجی	گاز داخلی	گاز	گاز	پاشش
(l/min)	(l/min)	خارجى	داخلى	
_	_	بدون محافظت		A1
۴.	-	Ar	-	<b>S1</b>
۳.	10	Ar	Ar	<b>S2</b>
۳.	١٠	Ar	$H_2$	<b>S</b> 3
٣.	۲.	Ar	$H_2$	<b>S</b> 4
٣٠	٣٠	Ar	$H_2$	<b>S</b> 5

ذرات پاششی و پوششهای اعمال شده ZrC با تهیه تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی (<sup>۷</sup>SEM) و پراش اشعه ایکس (<sup>۸</sup>XRD) مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین درصد تخلخل و اکسید این پوششها ارزیابی گردید. مقدار تخلخل پوشش ها با استفاده از تصاویر سطح مقطع آنها به کمک نرم افزار پردازش تصویر 3

<sup>7</sup> Scanning Electron Microscopy

<sup>8</sup> X-Ray Diffraction

اندازه گیری شده است. همچنین مقدار اکسید پوششها با کمک نرم افزار.X-pert Pro، محاسبه شد. در بررسی های ریزساختاری به مقدار ذرات کاملا ذوب شده که به شکل اسپلتهای هموار در سطح پوشش مشاهده می شوند و ذرات ذوب نشده و نیمه ذوب و

**جدول**۴. کد پوشش،ها و نرخ تزریق گاز محافظ در فرآیند پاشش

تخلخلها و ترکهای موجود در پوشش توجه شده است.

-			C	
SPS4	SPS3	SPS1	APS	کد پوشش متغیر
۲.	۱.	صفر	صفر	گاز H <sub>2</sub> داخلی(l/min)
٣.	۳.	٣.	صفر	گاز Ar خارجی
				(l/min)

## نتايج و بحث

در شکل ۲ تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی حاصل از آزمون پاشش تک عبور ذرات ZrC با روش APS و همچنین با روش SSPS و تزریق گازهای داخلی Ar و H2 مطابق با جدول ۳ آورده شدهاند. بر اساس این جدول در کلیه حالتهای پاشش ذرات با روش SSPS، گاز محافظ خارجی آرگون و با نرخ ثابت می باشد.

مطابق با شکل ۲، ذرات نشسته روی شیشه حاصل از پاشش تک عبور، شامل اسپلتها یا ذرات کامل ذوب شده، ذرات نیمه ذوب یا ذوب نشده و ذرات ریز کروی میباشند. با مقایسه تصاویر ۲-لف و ۲-ب مشاهده میشود در پاشش ذرات با استفاده از غلاف جامد و بدون تزریق گاز محافظ داخلی (حالت S1 مطابق با جدول ۳)، نسبت به روش اتمسفری حالت A1، ذرات اسپلتی یا نسبت به روش اتمسفری حالت A1، ذرات اسپلتی یا ذرات کاملا ذوب شده بیشتری ایجاد شده که متأثر از نقش موثر غلاف جامد است. با این حال و با بررسی شکل ۲-پ مشاهده میشود در پاشش ذرات CrC در جامد، منجر به افزایش میزان ذرات ذوب نشده و ریز کروی در مقایسه با شکل ۲-ب شده است. این موضوع

می تواند ناشی از تأثیر جریان گاز آرگون محافظ داخلی بر کاهش دمای ذرات در جت پلاسما باشد که موجب افزایش ذرات ذوب نشده شده است. در شکلهای ۲-ت تا ۲-د ذرات در آزمون پاشش تک عبور با تزریق گاز محافظ داخلی هیدروژن با نرخ های متفاوت بر مورفولوژی این ذرات مشاهده شده است.

شکل در S3 دارای حفرات داخلی بوده و درجه پهن شدگی (Flattening) آن نسبت به نمونه S4 با نرخ تزریق Vmin 20 کمتر است. با افزایش نرخ گاز داخلی هیدروژن به ۲۰۱/min، در شکل ۲- ج (مربوط به حالت S4) که با برش یک قسمت و بزرگنمایی بالای آن ذره مشاهده می شود، ذرات ذوب



شکل ۲. تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از ذرات ZrC حاصل از آزمون پاشش تک عبور ، الف) کد A1، ب) کد S1، پ) کد 28، ت) کد S3، ج) کد S4 و د) کد S5 (فاصله پاشش از لبه غلاف ۱۰ ها ۱۰، گاز Ar محافظ بیرونی ۱۰m ۳۰، نرخ تزریق پودر g/min).

> جت پلاسما دارای نواحی مختلف به لحاظ دمایی بوده و ذرات در فرآیند پاشش پلاسمایی با توجه به عبور از هسته مرکزی جت پلاسما با دمای بالاتر میتوانند به صورت کاملا ذوب یا اسپلت و یا عبور از نواحی اطراف هسته مرکزی جت با دمای کمتر، بصورت نیمه جامد یا ذوب نشده به زیرلایه برسند.

همانگونه در شکل ۲-ت مربوط به حالت S3 مشاهده می شود، با تزریق گاز داخلی هیدروژن با نرخ تزریق ۱۰ /min و با وجود غلاف جامد، میزان ذرات ذوب شده اسپلتی نسبت به حالت پاشش اتمسفری بدون غلاف جامد (A1) افزایش داشته است. با این حال ذرات اسپلتی

شده اسپلتی بیشتر با درجه پهن شدگی بالاتر در نقاط مختلف روی سطح نشستهاند. با اینحال و با افزایش بیشتر نرخ تزریق گاز هیدروژن از ۲۰ به ۱/min ۳۰ و طبق تصویر شکل ۲-د، مقدار ذرات نشسته روی سطح شیشه در حالت 25 بهطور قابل ملاحظهای درمقایسه با نرخهای تزریق گاز ۲۹ ۱۰ و ملاحظهای درمقایسه با نرخهای تزریق گاز ۲۰۱ و نرخ گاز تزریق شده داخلی به ۳۰۱/min درون غلاف جامد و فشار حاصل از آن مانع از امکان ورود پودرهای ZrC یا موجب کاهش امکان تزریق آنها از طریق نازل

تزریق پودر به درون جت پلاسما شده است. به منظور

و سوختن آن در غلاف جامد باشد. سوختن هیدروژن در غلاف علاوه بر اینکه باعث افزایش دمای محیط اطراف جت می شود، با مصرف اکسیژن محیط در حین سوختن موجب کاهش اکسیژن موجود در جت و اکسیداسیون کمتر ذرات در حین پاشش می شود [۱۴].

لذا مشاهده می شود، استفاده از غلاف جامد و تزریق گاز هیدروژن با نرخ ۱/min ۲۰، موجب تشکیل ذرات ذوب شده بیشتر و با همواری بیشتر بر روی سطح شده است. در شکل ۳ تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) از سطح پوشش های ZrC اعمال شده با روش های APS و

SSPS مشاهده می شود. پوشش های اعمال شده با غلاف جامد و تحت حفاظت گازهای محافظ (SSPS) بر طبق جدول ۴ کد گذاری شده و نرخ گازهای محافظ این پوشش ها مطابق با نرخ گازهای محافظ در پاشش ذرات در حالتهایS1، S3 و S4 که در آزمون پاشش تک عبور ذرات موجود در جدول ۳ که شرایط بهتری داشتهاند، انتخاب شدهاند.

مشاهده مقدار ذرات رسوب کرده کمتر در تزریق گاز محافظ داخلی با نرخ ۳۰۱/min، در شکل ۲-د از تصویر با بزرگنمایی کمتر استفاده شد تا سطح بیشتری از سطح مشاهده شود و اثر فشار بالای گاز داخلی هیدروژن در ممانعت از خروج پودر پاششی به خوبی دیده میشود. همانگونه که در شکل ۱-ب مشاهده می شود جریان گازهای محافظ داخلی H2 و Ar خارجی موازی با جت پلاسما و جریان تزریق پودرها عمود بر جریان جت و به داخل جت مى باشد. لذا جريان گاز محافظ داخلى هیدروژن با نرخ تزریق بالا ( ۳۰۱/min) بر حرکت این پودرها موثر است. در تصاویر مختلف شکل ۲، ذرات نیمه ذوب و ذوب نشده نیز علاوه بر ذرات کاملا ذوب شده اسپلتی نشان داده است. کاهش مقدار ذرات ذوب نشده و یا ذرات نیمه ذوب و تشکیل ذرات کاملا ذوب شده و اسیلتهای یهنتر میتواند به دلیل افزایش آنتالیی و حرارت اطراف جت پلاسما (و توان بالاتر در ذوب ذرات) ناشی از افزایش نرخ تزریق گاز هیدروژن دو اتمی



شکل ۳. تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی(SEM) از سطح پوشش های ZrC ، الف) کد APS، ب) کد SPS1، پ) کد و ت) کد SPS4 (طبق کدهای جدول ۳).

با توجه به نتایج نامناسب آزمون پاشش ذرات مربوط به حالتهای S2 و S5 به ترتیب مربوط به تزریق گاز آرگون داخلی و گاز هیدروژن داخلی با نرخ ۳۰l/min اعمال پوشش با این پارامترها با روش SSPS انجام نشد و پوششهای مربوط به حالتهای S1، S3 و S4 اعمال و با پوشش حالت A1 مقایسه شده است.

همانگونه که مشاهده می شود ریز ساختار کلیه پوشش های اعمال شده با روش پاشش پلاسمایی، مانند اغلب پوشش های پلاسمایی شامل اسپلت ها یا ذرات ذوب و پهن شده، ذرات نیمه ذوب، حفرات، ترک های ریز و تخلخل می باشند [ ۱۵]. همان گونه که از این شکل مشاهده می شود، با مقایسه تصاویر شکل ۳ (ب، پ و ت) پوشش های ZrC اعمال شده با روش SSPS و تحت حفاظت غلاف جامد و گاز هیدروژن داخلی نسبت به پوشش APS (شکل ۳-الف) منجر به ایجاد پوشش های با کیفیت بالاتری شده است.

استفاده از غلاف جامد و تزریق گاز هیدروژن داخلی با نرخ I/min ۱۰ (در پوشش کد SPS3) و افزایش آن تا دوب شده و اسپلتهای هموارتر و حفرات کمتر شده است. وجود غلاف جامد و تزریق گاز هیدروژن، باعث حفظ گرما و افزایش دمای اطراف جت پلاسما که موجب افزایش توان و ذوب شدن ذرات بزرگتر پودر اولیه وارد شده به جت و پهنشده گی بیشتر در برخورد به سطح زیرلایه و همواری سطح پوششهای اعمالی با SSPS شده است. این موضوع با مقایسه شکلهای ۳-پ و ت بیشتر مشخص می شود. در بررسی سطوح پوشش مشاهده می شود، پوشش اعمال شده با نرخ تزریق ۲۰ از کیفیت بالاتر به لحاظ ساختار پوشش پلاسمایی برخوردار است.

در شکل ۴ نتایج آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) از پوششهای APS و SPS3 نشان داده شده است.

همانگونه که در شکل ۴ مشاهده می شود پوشش های ایجاد شده، شامل فاز ZrC و همچنین فازهای اکسیدی ZrO<sub>2</sub> و ZrO<sub>3</sub> است.



شکل ۴. نتایج آنالیز فازی (XRD)، الف) از پوشش APS و ب) پوشش SSP4

اگرچه با استفاده از روش SSPS نمی توان به طور کامل از ورود اکسیژن به درون جت پلاسما ممانعت به عمل آورد و فازهای اکسیدی در پوشش مشاهده می شوند، با این حال کاهش مقدار اکسیژن و هوای ورودی با وجود غلاف جامد و همچنین هیدروژن تزریق هیدروژن و مصرف شده در جت پلاسما، موجب کاهش مقادیر اکسید مصرف شده در جت پلاسما، موجب کاهش مقادیر اکسید مرب یوشش SPS4 نسبت به پوشش APS شده است. بررسی دقیق تر این موضوع با استفاده از نرم افزار Typert بررسی دقیق تر این موضوع با استفاده از نرم افزار Xpert پذیرفت که مطابق تصاویر شکل ۴، درصد مجموع پذیرفت که مطابق تصاویر شکل ۴، درصد مجموع اکسیدهای موجود در پوشش SPS4 بیش از ۵۰٪ کاهش

موجود در پوششهای APS و SSPS با آنالیز تصویری پوششها اندازهگیری و ارائه شده است.



شکل ۵. درصد تخلخل در پوشش های SPS3 ،SPS1 ،APS و SSP4

برای این منظور تعدادی از تصاویر سطح مقطع از پوششهای اعمال شده مورد بررسی قرار گرفتند. همانگونه که مشاهده میشود پوششهای اعمال شده با روش SSPS نسبت به روش APS، دارای مقدار تخلخل کمتری میباشند. همچنین با مقایسه بین پوششهای SSPS نیز مشاهده میشود نمونه SPS4 اعمال شده در غلاف جامد و با نرخ تزریق گاز هیدروژن imin دارای کمترین مقدار تخلخل و در حدود ۳٪ است. همانگونه که در بررسی ریزساختار پوششها نیز مشاهده شد پوشش SPS4 دارای ذرات ذوب شده و اسپلتهای sSPS رو مقادیر اکسید کمتری در بین پوششهای SSP3 بوده و ساختار پوشش با ذرات ذوب شده بیشتر و اسپلتهای هموارتر و مقدار اکسید کمتر بین لایههای پوشش، موجب کاهش تخلخل در پوشش SPS4 شده

در شکل ۶ .به منظور بررسی و .مقایسه کیفیت ریزساختار پوششهای ZrC اعمال شده با روش APS و با روش SSPS با نرخ تزریق گاز هیدروژن داخلی ۲۰ /min (SPS4)، تصاویر سطح مقطع این پوشش ها ارایه شده است. همانگونه که در این شکل نیز مشاهده می شود،

مقدار تخلخل و حفرات موجود در پوشش SPS4 کمتر از نمونه APS می باشد و تراکم و یکنواختی پوشش بیشتر است.





شکل ۶. سطح مقطع پوشش های ZrC اعمال شده با روش الف) APS و ب) SPS4 با تزریق گاز هیدروژن داخلی ۲۰ I/min.

همانگونه که در بررسی مقدار تخلخل پوششهای مختلف در شکل ۵ نیز مشاهده شد، استفاده از غلاف جامد با تزریق گاز محافظ موجب کاهش مقدار تخلخل پوشش و کیفیت بالاتر پوشش می شود.

از جمله منابع ایجاد حفره و تخلخل، مکانهای خالی بین لایههای اسپلتی، نواحی اطراف لبه اسپلتها و ذرات ذوب نشده و اکسیدها در پوشش هستند. از این رو با کنترل شرایط پاشش و نقش مثبت غلاف جامد در کاهش ورود هوای اطراف و همچنین تزریق هیدروژن داخلی با نرخ تزریق بهینه که در غلاف به همراه اکسیژن موجود prepared by supersonic plasma spraying, Journal of the European Ceramic Society, 36 (2016) 3739-3746.

4. Y. Jia, H. Li, Q. Fu, Z. Zhao, and J. Sun, *Ablation resistance of supersonic-atmosphereplasma-spraying ZrC coating doped with ZrO*<sub>2</sub> for *SiC-coated carbon/carbon composites*, corrosion Science, 123 (2017) 40-54.

5. A. Abdollahi, N. Ehsani and Z. Valefi, *High* temperature ablation-oxidation performance of SiC nanowhisker toughened-SiC/ZrB2-SiC ultra-high temperature multilayer coatings under supersonic flame, Journal of Alloys and Compounds, 745(2018) 798-809.

6. R. Aliasgarian, M. Naderi and S. E. Mirsalehi, *Ablation mechanism of ZrB2-SiC coating for SiC-coated graphite under an oxyacetylene flame*, Surface & Coatings Technology, 350 (2018) 511–518.

7. B. Chen, L. Zhang, L. Cheng and X. Luan, *Viscous Flow of Silica and its Effects on Ablation of Carbon/Silicon Carbide Composites as a Liquid-Fueled Rocket Engine Nozzle*, Applied ceramic Technology, 8 (2011) 1468–1474.

8. T. Liu, Y. Niu, C. Li, X. Pan, M. Shi, X. Zheng and C. Ding, *Ablation resistance of ZrC-MoSi2/ZrC-SiC double-layered coating in a plasma flame*, Corrosion Science, 145 (2018) 239-248.

9. J. Pourasad and N. Ehsani, Synthesis of an oxidation-resistant SiC coating on graphite and modeling analysis with thermodynamics calculations, International Journal of Materials Research, 107 E (2016) 1-5.

10. S. Torabi, Z. Valefi , N. Ehsani, Ablation behavior of SiC/ZrB<sub>2</sub> ultra-high temperature ceramic coatings by solid shielding shrouded plasma spray for high-temperature applications (temperature above 2000 °C), Surface & Coatings Technology 403 (2020) 126271.

11. A.Eshaghi, Z. Valefi , N. Ehsani, *Ablation behaviour of ZrC coating by novel solid shielding/shrouded plasma spray*, Surface Engineering 37 (2021) 890-903.

12. A. Abdollahi, N. Ehsani and Z. Valefi, *Thermal* shock resistance and isothermal oxidation behavior of C/SiC-SiC nano functionally gradient coating on graphite produced via reactive melt infiltration (*RMI*), Materials Chemistry and Physics, 182(2016) 49-61.

13. B. R. Kang, H. S. Kim, P. Y. Oh, J. M. Lee, H. I. Lee and S. M. Hong, *Characteristics of ZrC Barrier Coating on SiC-Coated Carbon/Carbon Composite Developed by Thermal Spray Process*, Materials, 12(5) (2019) 747.

14. R. Saharkhiz, Z. Valefi, M. Mirjani, A. Abdollahi and S. Taghi-Ramezani, *Effect of hydrogen and argon shrouding gas flow rates on* 

سوخته و علاوه بر افزایش دما و گرمای محفظه موجب احیایی تر شدن محیط شده، به ایجاد پوشش با کیفیت بالاتر در نمونه SPS4 منجر شده است[۱۴و۱۷].

# نتيجه گيري

# جت و کاهش ذرات ذوب شده گردید.

### مراجع

1. R. Aliasgarian, M. Naderi, S. E. Mirsalehi and S. Safi, *The ablation behavior of ZrB<sub>2</sub>-SiC coating prepared by shrouded plasma spray on SiC-coated graphite*, Journal of Alloys and Compounds, 742 (2018) 797-803.

2. C. Hu, X. Ge, Y. Niu, , H. Li, L. Huang, X. Zheng and J. Sun, *Influence of Oxidation Behavior* of Feedstock on Microstructure and Ablation Resistance of Plasma-Sprayed Zirconium Carbide Coating, Journal of Thermal Spray Technology, 24 (2015) 1302-1311.

3. D.j. Yao, H.j. Li, H. Wu, Q.G. Fu and X.F. Qiang, *Ablation resistance of ZrC/SiC gradient coating for SiC-coated carbon/carbon composites* 

high-temperature oxidation behavior of NiCrAlY coating by solid shielding shrouded plasma spray (SSPS), Surface and Coatings Technology, 394 (2020) 125818.

15. Y. Niu, Z. Wang, J. Zhao, X. Zheng, Y. Zeng and C. Ding, *Comparison of ZrB*<sub>2</sub>-*MoSi*<sub>2</sub> *Composite Coatings Fabricated by Atmospheric and Vacuum Plasma Spray Processes*, Journal of Thermal Spray Technology, 26 (2017) 100–107.

16. T. Liu, L. Zheng, H. Zhang, *Effect of Solid Shield on Coating Properties in Atmospheric Plasma Spray Process*, Journal of Thermal Spray Technology, 25(2016) 1502-1515.

17. J. Zhang and V. Desai, *Evaluation of thickness*, *porosity and pore shape of plasma sprayed TBC by electrochemical impedance spectroscopy*, Surface and Coatings Technology, 190 (2005) 98-109.